Влияние дегидратации на ферримагнитный резонанс в монокристаллах $[Cr(CN)_6][Mn(S)-pnH(H_2O)](H_2O)$

© Р.Б. Моргунов, Ф.Б. Мушенок

Институт проблем химической физики Российской академии наук, Черноголовка, Московская обл., Россия E-mail: morgunov20072007@yandex.ru

(Поступила в Редакцию 28 января 2009 г.)

В хиральном молекулярном магнетике $[Cr(CN)_6][Mn(S)-pnH(H_2O)](H_2O)$ исследовано влияние структурных фазовых переходов, вызванных дегидратацией, на спектры ферримагнитного резонанса для трех кристаллических модификаций. Установлены различия констант поля анизотропии и обменного взаимодействия, вызванные изменением размерности магнитного упорядочения при фазовых переходах. В дегидратированной аморфной фазе помимо ферримагнитного резонанса обнаружены дополнительные изотропные линии магнитного резонанса, отвечающие состоянию спинового стекла.

PACS: 75.50.Xx, 76.50.+g

1. Введение

Одним из недавних достижений молекулярного магнетизма является синтез серии хиральных металлорганических ферримагнетиков с цианидными обменными связями между ионами переходных металлов [1-6]. Одним из таких соединений является кристаллический материал $[Cr(CN)_6][Mn(S) - pnH(H_2O)](H_2O)$, где (S)-pn — 1,2-диаминопропан [1]. В этом соединении с относительно высокой температурой Кюри, получившем название Green Needle (GN), было обнаружено множество новых явлений, индуцированных хиральностью структуры и геликоидальным распределением спиновой плотности: магнитооптический дихроизм [1], необычная температурная зависимость эффективного магнитного момента, объясняемая дефектами магнитной структуры — хиральными спиновыми солитонами [2,3], наличие spin-flop-переходов в сильных магнитных полях [4]. Сочетание всех этих эффектов привлекает внимание к дальнейшему исследованию GN и установлению закономерностей возникновения магнитного упорядочения новых типов, не существующих в естественных природных материалах.

Кристаллы GN в фазе I образованы квазидвумерными волнистыми слоями (рис. 1, *a*), расположенными в плоскости *ab*, состоящими из чередующихся атомов Mn^{2+} и Cr^{3+} , связанными между собой группами CN. Отдельные слои связаны между собой силами Вандер-Ваальса. Атомы Cr^{3+} находятся в октаэдрическом окружении шести атомов углерода C, а для атомов Mn^{2+} октаэдрическое окружение образовано пятью атомами азота N и одним атомом кислорода О. Длинная ось координационного октаэдра атома Mn^{2+} при перемещении вдоль оси кристалла *c* испытывает вращение вокруг нее, т. е. кристаллическая структура GN характеризуется хиральностью.

Необычным свойством этих кристаллов являются множественные фазовые переходы, связанные с гидратаций/дегидратацией. В зависимости

от условий получения молекулярный ферримагнетик $[Cr(CN)_6][Mn(S)-pnH(H_2O)](H_2O)$ может находиться в трех фазах, атомная и магнитная структуры которых были установлены в [4,5]. Первоначально синтезированный образец кристаллов GN находится в фазе I (рис. 1, фаза I). Магнитные свойства этой фазы и ферримагнитный резонанс (ФМР) в ней были подробно описаны в [3,6], где было установлено, что анизотропия формы образца не вносит вклад в ориентационные зависимости спектров ФМР, которые отражают поле анизотропии кристаллической решетки.

При подогреве образца до температуры T = 310 К в воздушной атмосфере при 100% влажности происходит обратимый структурный фазовый переход фазы I в фазу II (рис. 1, фаза II), связанный с изменением позиции группы CH₃. Если в дальнейшем образец выдерживается в вакууме при температуре $T = 320 \, \text{K}$, происходит дегидратация кристаллов фазы II, т.е. из каждой элементарной ячейки теряется две молекулы кристаллогидратной воды. Так образуется фаза III кристаллов GN (рис. 1, фаза III). Эти преобразования обратимы — при комнатной температуре кристаллы фазы III вбирают из окружающего воздуха воду, т.е. происходит регидратация, и фаза III снова обратимо переходит в фазу I. Во всех трех фазах кристаллы GN имеют ромбическую пространственную группу Р212121 и являются ферримагнетиками с температурами Кюри $T_c = 38 \,\mathrm{K}$ в фазе I, $T_c = 40 \,\mathrm{K}$ в фазе II и $T_c = 73 \,\mathrm{K}$ в фазе III [6]. Методом нейтронной дифракции было установлено [7], что магнитные группы симметрии для антиферромагнитного упорядочения подрешеток хрома и марганца для фаз I и II соответствуют Г₄, а для фазы III магнитная симметрия отвечает группе $\Gamma_{2X}\Gamma_{3YZ}$. Это позволяет ожидать сходство параметров магнитной анизотропии между фазами I и II и их отличие от фазы III.

Авторам не известно об исследовниях поля анизотропии и его взаимосвязи с фазовыми превращениями в кристаллах GN, для которых были получены лишь



Рис. 1. Атомная структура (слева) и соответствующие спектры ФМР (справа) монокристаллов Green Needle для фаз I (*a*), II (*b*) и III (*c*). Угол ϕ между направлением постоянного магнитного поля и осью кристаллов *c* равен 120°, T = 3 К. Группа линий 1 -спектр исследуемого кристалла Green Needle, линия 2 соответствует сигналу калибровочного образца CuSO₄ · 5H₂O.

температурные и полевые зависимости намагниченности. В частности, для фаз II и III не проводилось исследований спектров ФМР и их сравнительного анализа с фазой I. Поэтому целью этой работы является обнаружение влияния кристаллических структурных фазовых переходов, вызванных дегидратацией монокристаллов GN, на их спектры ФМР, а также на параметры поля анизотропии и обменного взаимодействия.

2. Методика экспериментов и приготовление образцов

Монокристалл GN имел форму тонкой прямоугольной пластинки размером $\sim 2 \times 0.3 \times 0.01$ mm. Для изучения электронного парамагнитного резонанса на кристаллах GN использован спектрометр Bruker ESP 300E *X*-диапазона, работающий на частоте ~ 9.4 GHz с прямоуголь-

ным резонатором H_{102} , частотой модуляции 100 kHz и диапазоном развертки постоянного магнитного поля H = 0-1.5 T. Кристалл GN помещался в пучность магнитного поля. В ходе проведения измерений контролировалась добротность резонатора 4000–10 000. Спектры ЭПР записывали в виде зависимости первой производной мнимой части магнитной восприимчивости $d\chi/dH$ от величины магнитного поля. Температура варьировалась в диапазоне 3–291 К. В качестве калибровочного образца магнитной восприимчивости использовались монокристаллы CuSO₄ · 5H₂O. Магнитная восприимчивость образца получена двукратным интегрированием спектра ЭПР.

Все измерения проводили на одном и том же образце, находящемся в различных фазовых состояниях, создаваемых согласно условиям, описанным во Введении. При фазовом переходе форма образца и его размеры существенно не изменялись.

3. Экспериментальные результаты

При температурах, бо́льших соответствующих температур Кюри каждой из фаз (т.е. в парамагнитном состоянии), в кристаллах наблюдается одиночная линия лоренцевой формы. Спектры ФМР для каждой из фаз I, II, III при низких температурах (в магнитоупорядоченном состоянии) представлены на рис. 1 вместе с соответствующими кристаллическими структурами фаз. Спектры ФМР исследуемого кристалла обозначены цифрой *1*, а спектр калибровочного образца CuSO₄ · 5H₂O, находившегося в одном капилляре вместе с исследуемым образцом, обозначен цифрой *2*.

В фазе I наблюдаются множественные резонансные линии, которые, как было показано в [2,3], являются наложением спектров спин-волнового и спин-солитонного резонансов (рис. 1, a). Самая интенсивная из них отвечает возбуждению однородной спиновой прецессии, т. е. нулевой моды ферримагнитного резонанса. Эта линия будет использована нами для определения угловых зависимостей ФМР и поля параметров анизотропии. В фазе II наблюдается одиночная линия лоренцевой формы, обладающая сильной анизотропией (рис. 1, b). В спектре фазы III имеются одна сравнительно узкая линия в слабых полях и несколько широких линий в сильных полях (рис. 1, c).

3.1. Анизотропия ФМР фазы I. Для определения параметров поля анизотропии монокристалла GN фазы I были получены полярная и азимутальная зависимости спектра ЭПР от углов ϕ и θ между постоянным магнитным полем спектрометра **H** и осями кристалла *c* и *a* соответственно при температуре 3 K (рис. 2, *a*, *b*). Для получения этих зависимостей кристалл вращали в плоскости *bc* (рис. 2, *a*) и в плоскости *ac* (рис. 2, *b*). При температуре T = 3 K увеличение угла θ от 0 до 90° приводит к увеличению резонансного поля H_{res} до максимума. При дальнейшем увеличении угла θ резонансное поле уменьшается, достигая минимума при



Рис. 2. Зависимости резонансного поля H_{res} спектра ФМР монокристалла Green Needle фазы I от угла φ между направлением постоянного магнитного поля и осью *c* кристалла (*a*) и от угла θ между направлением постоянного магнитного поля и осью *a* кристалла (*b*) при температуре T = 3 К. Сплошными линиями показана аппроксимация теоретическими зависимостями, описанными в тексте.

 $\theta = 180^{\circ}$. Температурные зависимости основной моды ферримагнитного резонанса и всего спектра в целом подробно описаны в [2,6].

3.2. Анизотропия и температурные зависимости ФМР фазы II. Для определения параметров поля анизотропии монокристалла GN фазы II была получена зависимость вида спектра ЭПР от угла θ между постоянным магнитным полем спектрометра Н и осью а кристалла. Угловые зависимости были получены при температурах 3, 35 и 70 К вращением в плоскости *ac* (рис. 3, *a*). При температуре T = 3 K увеличение угла θ от 0 до 90° приводит к увеличению резонансного поля H_{res}, при дальнейшем увеличении угла θ резонансное поле уменьшается, достигая минимума при $\theta = 180^{\circ}$. При увеличении угла θ от 180 до 270° резонансное поле $H_{\rm res}$ вновь возрастает, достигая максимума (рис. 3, а). С увеличением угла в от 270 до 360° резонансное поле уменьшается. На зависимости ширины ΔH_{pp} линии 2 спектра ЭПР от угла θ



Рис. 3. *а*) Полярные зависимости резонансного поля H_{res} спектра ФМР монокристалла Green Needle фазы II от угла θ между направлением постоянного магнитного поля и осью *а* кристалла при температуре T = 3 (1), 35 (2) и 70 K (3). На вставке показана ориентация кристалла в постоянном магнитном поле *H*. Сплошными линиями показана аппроксимация теоретическими зависимостями, описанными в тексте. *b*) Полярная зависимость ширины ΔH_{pp} линии спектра ФМР монокристалла Green Needle фазы II от угла θ между направлением постоянного магнитного поля и осью *a* кристалла при температуре T = 3 К. Сплошными линиями показана аппроксимация теоретическими зависимостями, описанными в тексте.

между осью *а* кристалла и направлением постоянного магнитного поля **H** при температуре T = 3 K (рис. 3, *b*) наблюдаются четыре максимума различной амплитуды, два из которых отстоят "слева" и "справа" на ~ 20–30° от $\theta = 90^{\circ}$, а два других находятся "слева" и "справа" на расстоянии ~ 20–30° от $\theta = 270^{\circ}$.

При увеличении температуры до 35 К наблюдается угловая зависимость резонансного поля H_{res} , сходная с угловой зависимостью при T = 3 К, но с меньшими значениями максимального резонансного поля при $\theta = 90$ и 270° и большими значениями минимального резонансного поля при $\theta = 0$ и 180° (рис. 3, *a*). Это указывает на уменьшение поля анизотропии с ростом температуры. При температуре T = 70 К резонансное

поле $H_{\rm res}$ практически не зависит от угла θ между постоянным магнитным полем и осью *а* кристалла, т.е. линия магнитного резонанса в парамагнитном состоянии становится изотропной (рис. 3, *a*). Ширина ΔH_{pp} линии при температурах T = 35 и 70 К зависит от угла θ гораздо слабее, чем при T = 3 К (на рисунке не показана).

Для определения типа магнитного упорядочения и его критической температуры была измерена зависимость вида спектра ЭПР от температуры в диапазоне $T = 4 - 300 \, \text{K}$. Постоянное магнитное поле **H** было параллельно оси b кристалла и перпендикулярно оси a. При уменьшении температуры Т от 300 до 100 К резонансное поле $H_{\rm res}$ и ширина ΔH_{pp} линии остаются постоянными с точностью проведения эксперимента (рис. 4, *a*). Дальнейшее понижение температуры от 100 до 55 К приводит к уменьшению ширины ΔH_{pp} в ~ 1.6 раза и не изменяет резонансного поля. Уменьшение температуры от 55 до 4К вызывает резкий рост как резонансного поля $H_{\rm res}$, так и ширины ΔH_{pp} резонансной линии (рис. 4, а). Для определения критической температуры магнитного упорядочения нами была построена температурная зависимость произведения γT высокочастотной магнитной восприимчивости γ на температуру Т. В таких координатах парамагнитному



Рис. 4. Температурная зависимость резонансного поля H_{res} и ширины $\Delta H_{pp}(a)$ и произведения магнитной восприимчивости на температуру χT линии 2 спектра ФМР для монокристалла Green Needle фазы II. Постоянное магнитное поле **H** параллельно оси *b* кристалла и перпендикулярно оси *a*.



Рис. 5. Зависимость резонансных полей *H*_{res} линий спектра ФМР монокристалла Green Needle фазы III от температуры *T*. Различные символы соответствуют разным резонансным линиям.

образцу соответствует прямая линия, параллельная оси абсцисс. Отклонение от этой зависимости позволяет судить о величине и знаке обменного взаимодействия. В интервале температур T от 300 до 55 K зависимость χT остается постоянной, а уменьшение T от 55 до 15 K приводит к быстрому росту произведения χT . Дальнейшее понижение температуры до 4 K вызывает уменьшение χT (рис. 4, b). Полученные зависимости хорошо согласуются с температурными зависимостями магнитного момента образца, полученного в постоянном магнитном поле в СКВИД-магнитометре [4].

3.2. Анизотропия и температурная зависимость ФМР фазы III. Для фазы III монокристалла GN, как и для фазы II, были получены зависимости спектра ФМР от температуры T в диапазоне от 4 до 300 К в случае, когда поле спектрометра **H** параллельно оси *c* кристалла, а также угловые зависимости при температуре T = 4 К.

В диапазоне температур 73-300 К в спектре ЭПР наблюдается одна линия, которой соответствует резо-

нансное поле $H_{\rm res} = 3400$ Ое (рис. 5). Понижение температуры ниже точки Кюри 73 К приводит к расщеплению одиночной линии на пять резонансных линий, у которых температурные зависимости резонансных полей различаются (рис. 5). Различаются и угловые зависимости этих линий, из которых лишь одна (в слабых полях) обладает заметной анизотропией. Остальные линии в пределах погрешности экспериментов были изотропны (рис. 6). При углах, близких к 0° (или 180°), в сильных полях появляются дополнительные интенсивные линии, которые не наблюдаются в остальном диапазоне углов.

4. Обсуждение

4.1. Обменные взаимодействия. При температурах, бо́льших ~ 40 К, экспериментальные точки зависимости произведения χT магнитной восприимчивости на температуру от температуры T (рис. 4, *b*) фазы II GN с высокой точностью укладываются на прямую,

Фаза	$K_{2\perp}, \ 10^6 {\rm erg/cm}^3$	$K_{2\parallel}, \ 10^6 {\rm erg/cm}^3$	$K_{4\perp}, \ 10^6 \ {\rm erg/cm}^3$	$K_{4\parallel}, \ 10^6 {\rm erg/cm^3}$
Ι	0.216	-0.059	0.036	-0.0085
II	0.210	-0.059	0.036	-0.0085
III	-1.17	0.045	_	-0.015

Параметры анизотропии второго и четвертого порядков в фазах I-III



Рис. 6. Азимутальные зависимости резонансного поля $H_{\rm res}$ линий спектра ФМР монокристалла Green Needle фазы III от угла ϕ между осью *c* кристалла и постоянным магнитным полем **H**. Различные символы соответствуют разным резонансным линиям. Сплошной линией показана аппроксимация теоретической зависимостью, описанной в тексте.

параллельную оси абсцисс. Из этого следует, что кристалл GN при температурах больше ~ 40 K находится в парамагнитном состоянии и температурная зависимость магнитной восприимчивости $\chi(T)$ подчиняется закону Кюри–Вейсса

$$\chi = \frac{C}{T - T_W},\tag{1}$$

где C — постоянная Кюри–Вейсса, T_W — парамагнитная температура Вейсса, величина которой указывает на интенсивность взаимодействия парамагнитных центров. Из аппроксимации высокотемпературной части зависимости $\chi(T)$ уравнением (1) была определена парамагнитная температура Вейсса $T_W = -114$ К. Близкое значение температуры Вейсса $T_W = -115$ К было получено ранее для монокристаллов GN фазы I [6]. Температура Вейсса T_W в теории молекулярного поля Вейсса связана с величиной обменного интеграла J выражением [8]

$$3k_B T_W = 2z J s(s+1), \tag{2}$$

где k_B — постоянная Больцмана; z = 6 — количество ближайших соседей, учитываемое внутри слоя в предположении, что между слоями обменное взаимодействие отсутствует; s — спин ионов, участвующих в обмене. Так как в обменном взаимодействии в кристалле GN в любой фазе участвуют ионы Cr^{3+} ($s_{Cr} = 3/2$) и ионы Mn^{2+} ($s_{Mn} = 5/2$), обладающие различными спинами, величина s(s + 1) в выражении (2) должна быть заменена на $\sqrt{s_{Cr}(s_{Cr} + 1)s_{Mn}(s_{Mn} + 1)}$.

На основании выражения (2) может быть подсчитан обменный интеграл, величина которого составляет $J/k_B = -5$ К. Равенство температур Вейсса для кристаллов и соответственно равенство обменных интегралов кристаллов GN фаз I, II свидетельствуют об одинаковой эффективности косвенного обмена в этих фазах и

подтверждают предположение о том, что в обеих фазах обменное взаимодействие действует в плоскости квазидвумерных слоев и весьма слабо между слоями. Таким образом, структурный фазовый переход между фазами I и II, заключающийся в развороте группы CH₃ (рис. 1), не изменяет величины обменного взаимодействия, хотя и существенно влияет на вид спектров ФМР и угловые зависимости резонансных линий.

В фазе III была получена температура Вейсса 38 К, значительно меньшая, чем в фазах I и II, в то время как температура Кюри, напротив, в фазе III самая высокая. Это означает, что учет ближайших соседей для обменного взаимодействия должен быть произведен иначе. "Переключение" связи между слоями при дегидратировании приводит к сближению этих слоев и возникновению межслойного обменного взаимодействия, превышающего обмен в слое. Эти оценки показывают, что в фазе III трехмерное магнитное упорядочение существенно отличается от фаз I и II. В [4] для фазы III предполагалось метамагнитное состояние на том основании, что в сильных магнитных полях до 20 Т было обнаружено скачкообразное увеличение магнитного момента. Однако, как известно, метамагнетики демонстрируют существенную анизотропию магнитных свойств, вызванную кристаллическим полем. Это противоречит данным о поле анизотропии (см. таблицу) и изотропному поведению линий магнитного резонанса (рис. 6). Поэтому можно сделать вывод о присутствии фазы спинового стекла, весьма характерной для хиральных магнетиков, поскольку хиральность спиновой структуры может приводить к состоянию спинового стекла [9].

Таким образом, анизотропные линии в слабых полях фазы III (рис. 6) могут быть отнесены к резонансу в ферримагнитной фазе с параметрами поля анизотропии, указанными в таблице. Изотропные линии в сильных магнитных полях можно отнести к состоянию спинового стекла, сосуществующего с ферримагнитной фазой.

4.2. Параметры поля анизотропии. Вклад в анизотропию резонансных полей ФМР ΜΟΓΥΤ вносить размагничивающее поле (анизотропия формы) и кристаллографическая анизотропия. По формуле Киттеля для размагничивающего поля тонкого диска, намагниченного перпендикулярно плоскости, $\omega_{\text{res}} = \gamma (H_0 - 4\pi M_s) \quad (\omega_{\text{res}} = 2\pi \nu, \nu = 9.4 \,\text{GHz}, \gamma$ гиромагнитное отношение, H_0 — внешнее магнитное поле, M_s — намагниченность насыщения), было рассчитано размагничивающее поле, равное 10 Ое. Это значение гораздо меньше, чем наблюдаемая на опыте анизотропия резонансных полей, и не может объяснить экспериментальных зависимостей резонансных полей от ориентации кристаллов. Поэтому в дальнейшем вклад анизотропии формы учитываться не будет.

Для установления параметров кристаллографической анизотропии фаз I и II угловые зависимости их резонансных полей H_{res} при температуре T = 3 K (рис. 2, 3)

были аппроксимированы выражением (3) [10]

$$\left(\frac{\omega}{\gamma}\right)^{2} = \frac{1}{M^{2}} \left[E_{\theta\theta} \left(\frac{E_{\varphi\phi}}{\sin^{2}\theta} + \frac{\cos\theta}{\sin\theta} E_{\theta} \right) - \left(\frac{E_{\theta\phi}}{\sin\theta} - \frac{\cos\theta}{\sin\theta} \frac{E_{\phi}}{\sin\theta} \right)^{2} \right], \quad (3)$$

где $\omega = 2\pi v$; $v = 9.4 \,\text{GHz}$ — частота микроволнового поля спектрометра; γ — гиромагнитное отношение; M — намагниченность образца; E — плотность свободной энергии; E_x , E_{xy} — первая и вторая производные плотности свободной энергии по соответствующим углам x и xy; θ — угол между осью a кристалла и вектором намагниченности **M**; φ — угол между осью cкристалла и вектором намагниченности **M**. Плотность свободной энергии E определяется выражением

$$E = -\mathbf{H}\mathbf{M} - K_{2\perp}\cos^2\theta - \frac{1}{2}K_{4\perp}\cos^4\theta \\ - \frac{1}{2}K_{4\parallel}\frac{1}{4}(3 + \cos 4\varphi)\sin^4\theta + K_{2\parallel}\sin^2\theta\cos^2(\varphi - \varphi_{2\parallel}),$$
(4)

где $K_{2\perp}, K_{2\parallel}$ — параметры анизотропии второго порядка (аксиальной) перпендикулярно и параллельно плоскости *ас* кристалла соответственно; *К*_{4⊥}, *K*_{4||} — параметры анизотропии четвертого порядка перпендикулярно и параллельно плоскости ас кристалла соответственно; θ , ϕ — углы между осями a, c кристалла и равновесным положением магнитного момента М. Так как при температуре $T = 3 \, \text{K}$ и внешним магнитном поле $H \sim 4 \,\mathrm{kOe}$ намагниченность образца в любой фазе находится в насыщении, направление вектора намагниченности М монокристалла GN совпадает с направлением постоянного магнитного поля Н. Поэтому углы ϕ и в соответствуют углам между постоянным магнитным полем Н и осями с и а кристалла. Момент насыщения M_s монокристаллов GN равен $2\mu_{\rm B}$ на формульную единицу, где $\mu_{\rm B}$ — магнетон Бора, поэтому в (1) и (2) $M = M_s = 11.2 \,\mathrm{emu/cm^3}$ [1]. С учетом этих данных из аппроксимации угловой зависимости были получены параметры магнитной анизотропии монокристаллов GN фаз I и II, которые приведены в таблице.

В фазе III аппроксимация угловой зависимости формулой (3) была возможна только для одной линии, расположенной в слабом магнитном поле (рис. 6). Полученные параметры поля анизотропии приведены в таблице, из которой следует, что поле анизотропии в метамагнитной фазе III значительно отличается от полей анизотропии квазидвумерных ферримагнетиков. Наличие изотропных резонансных линий в фазе III указывает на сосуществование разных магнитных фаз в кристалле. Можно предполагать, что магнитная фаза, отвечающая изотропным линиям, соответствует состоянию спинового стекла.

Для описания угловой зависимости ширины ΔH_{pp} линии лоренцевой формы ферримагнитного резонанса нами была учтена связь ΔH_{pp} с параметрами магнитной

анизотропии выражением вида [11]

$$\Delta H_{pp} = \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{1}{|\partial \omega / \partial H|} \frac{G}{M^2} \left(E_{\theta \theta} + \frac{E_{\varphi \varphi}}{\sin^2 \theta} \right), \quad (5)$$

где G — параметр Гильберта в уравнении Ландау– Лифшица для движения магнитного момента. На основании выражения (5) нами были рассчитаны зависимости ширин линий ΔH_{pp} от угла θ между магнитным полем спектрометра и осью *а* кристалла (рис. 3, *b*). Как видно из рис. 3, *b*, уравнение (5) в основном удовлетворительно описывает зависимость $\Delta H_{pp}(\theta)$, за исключением углов, соответствующих максимумам резонансного поля. Так как уравнение (5) применяется для ферримагнитного резонанса в материалах с трехмерным магнитным упорядочением, отклонение зависимости $\Delta H_{pp}(\theta)$ от уравнения (5) может быть вызвано квазидвумерностью кристаллов GN фазы II.

5. Заключение

Таким образом, анализ параметров поля анизотропии в трех фазах кристаллов GN указывает на сходство магнитного упорядочения в фазах I и II и на их сильное различие в фазе III. Эти данные вместе с параметрами обменного взаимодействия, полученными из температурных зависимостей, свидетельствуют о сложном спиновом состоянии кристаллов в фазе III. Сосуществование изотропных и анизотропных линий свидетельствует о наличиии двух магнитных фаз ниже температуры Кюри фазы III кристаллов GN, одна из которых, вероятно, соответствует спин-стекольному состоянию, а другая ферримагнитному состоянию.

Список литературы

- K. Inoue, K. Kikuchi, M. Ohba. Angew. Chem. Int. Ed. 42/39, D 3461 (2003).
- [2] R. Morgunov, M.V. Kirman, K. Inoue, Y. Tanimoto, J. Kishine, A.S. Ovchinnikov, O. Kazakova. Phys. Rev. B 77, 184419 (2008).
- [3] Р.Б. Моргунов, В.Л. Бердинский, М.В. Кирман, К. Inoue, J. Kishine, Y. Yoshida, Y. Tanimoto. ЖЭТФ 134, 95 (2008).
- [4] K. Inoue, Y. Yoshida, M. Kurmoo. Abstracts of II Russian-Japanese Workshop "Open shell compounds and molecular spin devices". Ekaterinburg (2008). P. 69.
- [5] Y. Yoshida, K. Inoue, M. Kurmoo. Chem. Lett. 37, 586 (2008).
- [6] И.В. Блохин, А.С. Маркосян, Р.Б. Моргунов, К. Inoue, Y. Tanimoto, Y. Yoshida. ФТТ 47, 2019 (2005).
- [7] C. Gonzales. PhD thesis. http://wwwold.ill.fr/Colleges/ thesards/clipsession2006/index.htm.
- [8] P.W. Anderson, P.R. Weiss. Rev. Mod. Phys. 25, 1, 269 (1953).
- [9] D. Grohol, K. Matan, J.-H. Cho, S.-H. Lee, J.W. Lynn, D.G. Nocera, Y.S. Lee. Nature Mater. 4, 323 (2005).
- [10] L. Baselgia, M. Warden, F. Waldner, S.L. Hutton, J.E. Drumheller, Y.Q. He, P.E. Wigen, M. Marysko. Phys. Rev. B 38, 2237 (1988).
- [11] S.V. Vonsovskii. Ferromagnetic Resonance. Pergamon, Oxford (1966).